

# GTOサイリスタ Gate Turn-off Thyristors

## ●GTO (Gate Turn-off Thyristors)

Type	V <sub>DRM</sub> (V)	I <sub>TCM</sub> (A)	I <sub>T(RMS)</sub> (A)	V <sub>TM</sub> (V)	I <sub>GT</sub> (A)	t <sub>gt</sub> * (μs)	t <sub>gq</sub> * (μs)	Q <sub>gq</sub> (μC)	T <sub>j</sub> (°C)	* MAX	
										Package	Note
GFT20A6	600	20	10	2.4	0.1	4.0	7.0	30	-40 ~ +125	③⑧	
GFT20B12	1,200	20	7	3.0	0.15	4.0	6.0	30		③⑧	
GFT50A6	600	50	20	2.5	0.3	4.0	7.0	75		③⑨	
GFT50B12	1,200	50	18	3.1	0.3	4.0	6.0	75		③⑨	
GFF90A6	600	90	42	2.3	0.4	4.0	7.0	150		④⑩	
GFF90B12	1,200	90	30	2.8	0.4	4.0	6.0	150		④⑩	
GFF200E12	1,200	200	70	3.8	0.6	4.0	6.0	300		④⑪	
GFP450A8	800	450	200	2.0	3.0	4.0	7.0	675		④⑫	
GFP450B12	1,200	450	200	2.0	3.0	4.0	7.0	675		④⑫	
GFP600B12	1,200	600	220							④⑫	
GFP600C16	1,600	600	270	2.5	1.0	10	15	1,000		④⑫	
GFP1000B25	2,500	1,000	400	2.5	1.5	10	30	3,000		⑤⑩	

## ●GTOゲートユニット (GTO Gate Units)

Type	V <sub>RM</sub> (V)	Input Drive Voltage (V)	Source Voltage (V)	Top (°C)	Note
UCZ01D50/90	1,200	4.5±0.5	±12±20%	-10~+75	
UCZ02D200	1,200	4.5±0.5	±12±20%	-10~+75	

# トライアック Triacs

## ●トライアック (Triacs)

Type	EIAJ No.		V <sub>DRM</sub> (V)	I <sub>T(RMS)</sub> (A)	I <sub>TSM</sub> (A)	V <sub>TM</sub> (V)	I <sub>GT</sub> * (mA)	T <sub>j</sub> (°C)	Package	Note
FSM3B2 FSM3B4			200 400	3	30	1.85	30(IQ+) 40(IQ-) 30(IIIQ-)	-40 ~ +110	③⑥	
FT08/09C FT08/09D FT08/09E FT08/09F FT08/09G	2SM155-200 2SM155-300 2SM155-400 2SM155-500 2SM155-600	2SM156-200 2SM156-300 2SM156-400 2SM156-500 2SM156-600	200 300 400 500 600	6	60	1.5	50(IQ+) 50(IQ-) 50(IIIQ-)	-40 ~ +125	08type ②④ 09type ②⑤	
FSM6B2 FSM6B4			200 400	6	74	1.7	30(IQ+) 30(IQ-) 30(IIIQ-)	-40 ~ +125	②③	
FS08/09C FS08/09D FS08/09E FS08/09F FS08/09G	2SM157-200 2SM157-300 2SM157-400 2SM157-500 2SM157-600	2SM158-200 2SM158-300 2SM158-400 2SM158-500 2SM158-600	200 300 400 500 600	10	80	1.4	50(IQ+) 50(IQ-) 50(IIIQ-)	-40 ~ +125	08type ②④ 09type ②⑤	
FSM10B4			400	10	95	1.7	30(IQ+) 30(IQ-) 30(IIIQ-)	-40 ~ +125	②③	